

A1N4007G-G

Voltage: 1000 V

Current: 1.0 A

RoHS Device

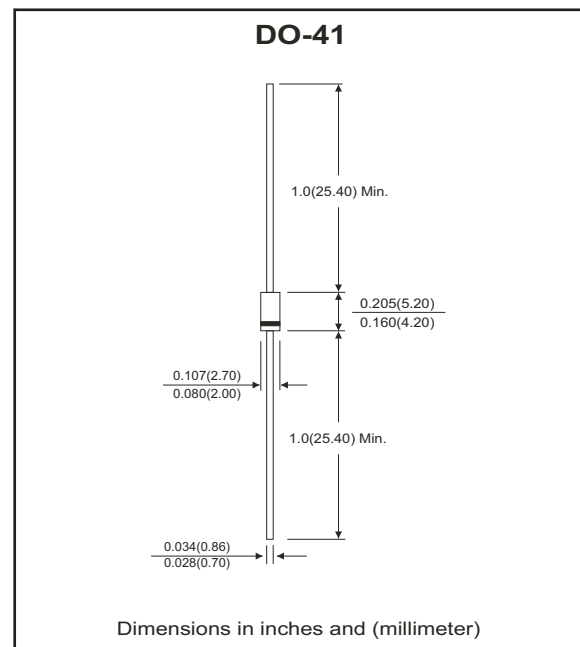


Features

- Low drop down voltage
- High current capability
- Low reverse leakage.
- High forward surge current capability.
- Glass passivated chip junction.
- Comply with AEC-Q101

Mechanical data

- Case: JEDEC DO-41 molded plastic
- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750 method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end
- Mounting position: Any
- Weight: 0.34 grams(approx.)



Circuit diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load derate current by 20%.

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Maximum recurrent peak reverse voltage		V_{RRM}	1000	V
Maximum RMS voltage		V_{RMS}	700	V
Maximum DC blocking voltage		V_{DC}	1000	V
Maximum average forward rectified current	see figure 1	$I_{(AV)}$	1	A
Peak forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) TL=110°C	I_{FSM}	30	A
Maximum instantaneous forward voltage	@ $I_F = 1A$	V_F	1.1	V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage	$T_A = 25^\circ C$	I_R	5	μA
	$T_A = 125^\circ C$		50	
Typical junction Capacitance	$V_R = 4V, f = 1MHz$	C_J	10	pF
Typical thermal resistance	Junction to ambient	$R_{\theta JA}$	45	°C/W
Operating junction temperature range		T_J	-55 ~ +125	°C
Storage temperature range		T_{STG}	-55 ~ +150	°C

Rating and Characteristic Curves (A1N4007G-G)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve

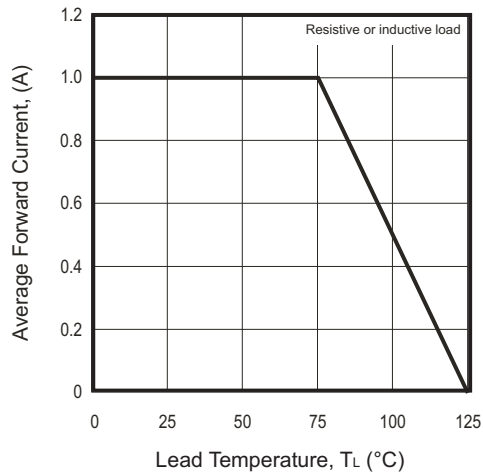


Fig.2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current

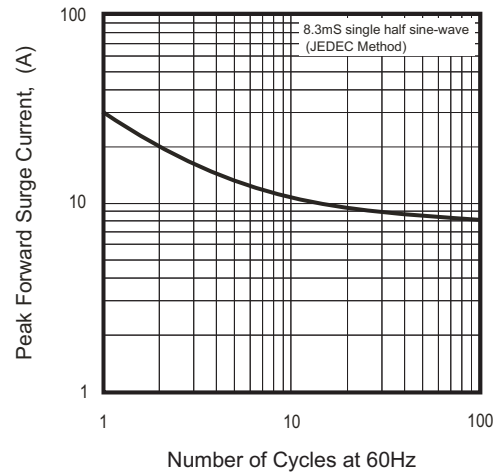


Fig.3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics

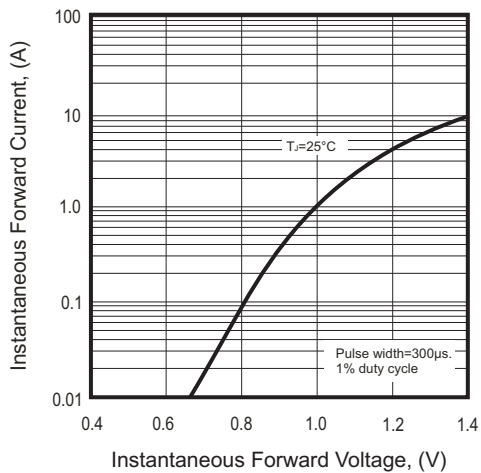


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

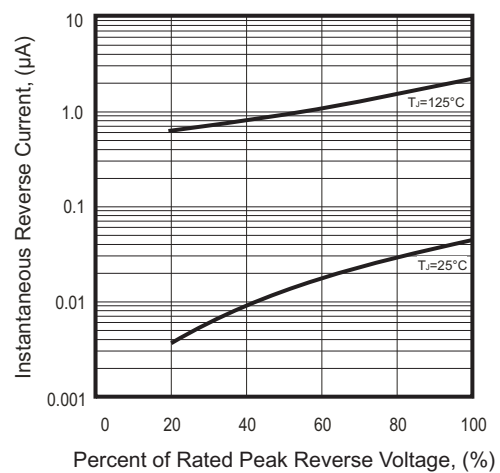
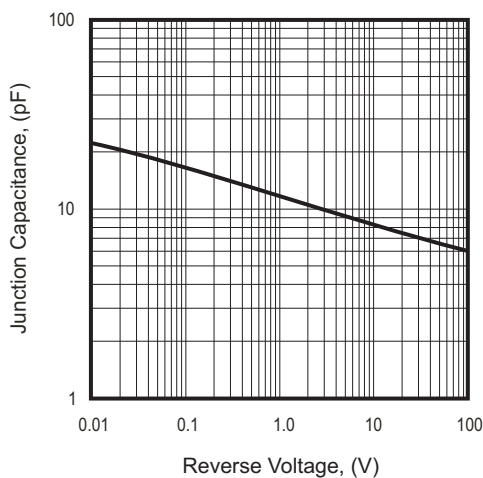
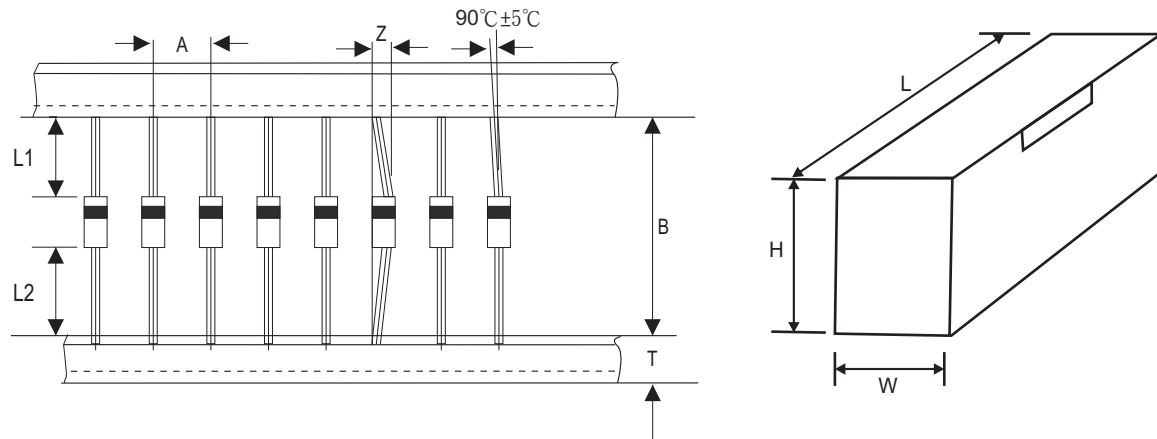


Fig.5 - Typical Junction Capacitance



Taping Specification For Axial Lead Diodes



DO-41	SYMBOL	A	B	Z	T	L1	L2
	(mm)	5.00 ± 0.50	52.00 ± 0.50	1.20 (max)	6.00 ± 0.40	1.00 (max)	1.00 (max)
	(inch)	0.197 ± 0.020	2.047 ± 0.020	0.047 (max)	0.236 ± 0.016	0.039 (max)	0.039 (max)

DO-41	SYMBOL	L	W	H			
	(mm)	260.00 ± 10.00	75.00 ± 10.00	140.00 ± 10.00			
	(inch)	10.236 ± 0.394	2.953 ± 0.394	5.512 ± 0.394			

Marking Code

Part Number	Marking Code
A1N4007G-G	1N4007G



1N4007G = Product type marking code

Standard Packaging

Case Type	AMMO PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
DO-41	5,000	50,000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9